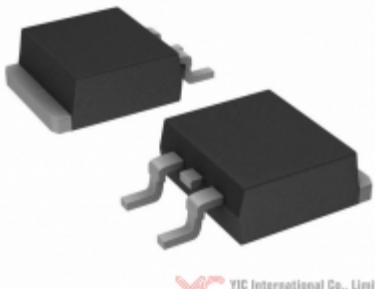


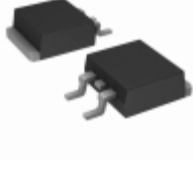






	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHB33N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>
	<p>Datenblätter:  SIHB33N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 1386 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB33N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1386 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3508pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk

SIHB33N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHB33N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHB33N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHB33N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHB30N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p>SIHB30N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p>SIHB33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>
 <p>SIHB33N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>	 <p>SIHB30N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p>SIHB33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB33N60EF-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	⇒ SIHA22N60E-E3
⊣ SIHA25N50E	⊗ SIHB12N50C	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50E
⊗ SIHB12N60E	⊣ SIHB12N60E-GE3	⊗ SIHB12N60E-GE3	↔ SIHB12N65E	⇒ SIHB15N50E
D SIHB15N60E-GE3	⊗ SIHB15N60E-GE3	⊣ SIHB15N65E	⊗ SIHB16N50C	⇒ SIHB16N50CTR-E3
⇒ SIHB18N60E	↔ SIHB33N60E-GE3	⊗ SIHD3N50D-GE3	⊣ SIHD3N50D-GE3	⇒ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⊗ SIHF10N40D-E3	⊣ SIHF12N50C
⊗ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	⇒ SIHF12N60E-E3
⊣ SIHF12N60E-GE3	⊗ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	⇒ SIHF15N60E
⊗ SIHF15N60E-E3	⊣ SIHF15N60E-E3	⊗ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	⇒ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⊗ SIHF16N50C-E3	⊣ SIHF16N50C-E3	⊗ SIHF18N50C-E3	⇒ SIHF18N50C-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited